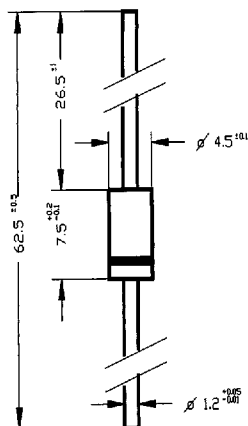


**High Voltage Si-Rectifier**

**Si-Hochspannungs-Gleichrichter**



Dimensions / Maße in mm

Nominal current Nennstrom	1.5...0.7 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	3000...7000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ DO-201
Weight approx. Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 10 siehe Seite 10

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Rep. peak reverse volt. Period. Spitzensperrspg. $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse volt. Stoßspitzensperrpanng. $V_{RSM}$ [V]	Max. fwd. current, R-load Dauergrenzstrom, R-Last $I_{FAV}$
BY 4000	3000	4000	1.5 A <sup>1)</sup>
BY 6000	5000	6000	1.0 A <sup>1)</sup>
BY 8000	7000	8000	0.7 A <sup>1)</sup>

Peak forward surge current, single half sine-wave,  $T_A = 25^\circ\text{C}$   $I_{FSM}$  100 A  
 superimposed on rated load  
 Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle,  
 überlagert bei Nennlast

Junction temperature – Sperrschichttemperatur  $T_j$  150 °C  
 Operating temperature – Betriebstemperatur  $T_A$  - 50...+150 °C  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur  $T_S$  - 50...+150 °C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1.5\text{ A}$ $I_F = 1\text{ A}$ $I_F = 0.7\text{ A}$	BY 4000 BY 6000 BY 8000	$V_F$ $V_F$ $V_F$	< 2.1 V < 3.2 V < 4.4 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$		$I_R$ $I_R$	< 1 $\mu\text{A}$ < 25 $\mu\text{A}$

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

**Taping of axial devices**

Most of Diotec's diodes and rectifiers are supplied taped with marked polarity facing the same direction. For device dimensions refer to the relevant data sheet.

Taped devices are shipped on reels with protective paper layers between the components.

**Gurtung axialer Bauelemente**

Nahezu alle Diotec-Dioden und Gleichrichter werden gegurtet. Dabei sind die Bauelemente so in den Gurt eingelegt, daß gleich gekennzeichnete Anschlüsse der gleichen Gurtseite zugewandt sind. Die Maße der Bauelemente sind in den betreffenden Datenblättern aufgeführt. Die gegurteten Bauelemente werden mit Papier-Zwischenlage auf Rollen geliefert.

**Tape dimensions for different device outlines  
Gurtabmessungen für verschiedene Gehäuse**

(all dimensions in [mm])

(alle Maße in [mm])

Case – Gehäuse Dim. – Abmeßg. Material	~DO-35 Ø 1.6 x 4 Glass	~DO-41 Ø 2.6 x 5.1 Epoxy	~DO-15 Ø 3 x 6.35 Epoxy	– Ø 3.05 x 14 Epoxy	~DO-201 Ø 4.5 x 7.5 Epoxy	– Ø 5.6 x 7.5 Epoxy	– Ø 8 x 7.5 Epoxy
Tape width b Bandbreite b	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1
Pitch s Raster s	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5 (10 ± 0.5)	10 ± 0.5	10 ± 0.5
Total width g Gurtbreite g	64 ± 2	64 ± 2	64 ± 2	64 ± 2	64 ± 2	64 ± 2	64 ± 2
Pieces per reel Stück pro Rolle	10000	5000	5000	5000	2500 (1500)	1500	1000
Reel diameter Rollen-Durchm.	350	350	350	350	350	350	350

**Taping of SMD**

Surface mount diodes and bridge rectifiers are delivered in Polystyrol tapes with a welded heat-sealable cover tape.

**Gurtung von SMD**

Dioden und Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage werden in Gurten aus Polystyrol mit geschweißten Deckbändern geliefert.

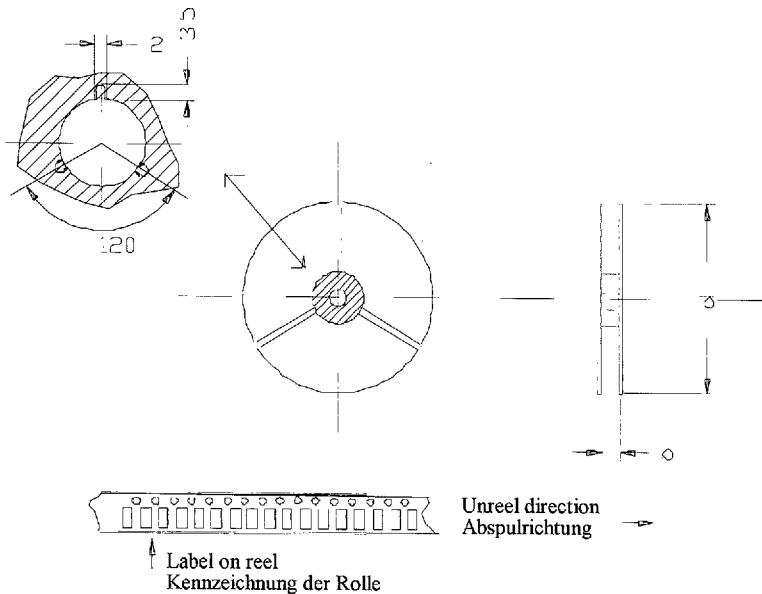
(all dimensions in [mm])

(alle Maße in [mm])

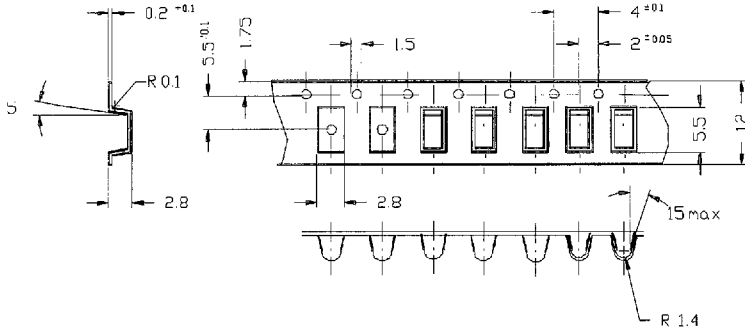
Device – Bauteil Case – Gehäuse Dimens. – Abmeßg.	Diode MiniMelf Ø 1.6 x 3.5	Diode Melf Ø 2.5 x 5	Diode Flatpack 3.7 x 5.4 x 2.3	Bridge – Brücke DIL 8.5 x 6.3 x 3.1	Bridge – Brücke Mini-DIL 4.7 x 3.9 x 2.7
Tape width b Gurtbreite b	8	12	12	16	12
Pitch s Raster s	4	4	8	12	8
Pieces per 13"-reel Stück pro 13"-Rolle	10000	5000	3000	1250	3000
Pieces per 7"-reel Stück pro 7"-Rolle	5000	1750	1000	–	750

c) Reel dimensions [mm]:

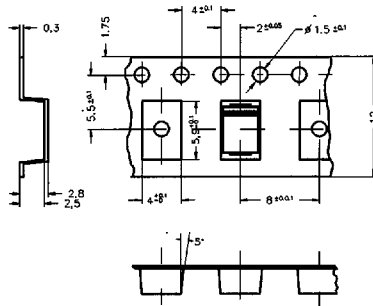
c) Maße der Rolle [mm]:



a) Taping of SMD-diodes in MELF-package:  
Gurtung von SMD-Dioden im MELF-Gehäuse:



b) Taping of SMD-diodes in square case (flatpack):  
Gurtung von SMD-Dioden im quadratischen Gehäuse:



c) Taping of SMD-bridge rectifiers in DIL- / Mini-DIL case:  
Gurtung von SMD-Brücken im DIL- / Mini-DIL Gehäuse:

